## ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ АМОРФНЫХ ПЛЕНОК Багмут А.Г., Багмут И.А., Резник Н.А.

## Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков

Обобщены электронно-микроскопические исследования "in situ", касающиеся кристаллизации аморфных пленок. Основываясь на анализе структуры и морфологии кристаллов, растущих в аморфных пленках в результате воздействия электронного луча, дана количественная трактовка слоевой полиморфной кристаллизации (СПК), островковой полиморфной кристаллизации (ОПК) и дендритной полиморфной кристаллизации (ДПК). Для кристаллизации определен безразмерный каждого типа относительной длины  $\delta_0$ , равный отношению характеристической длины к величине, связанной с размером элементарной ячейки кристалла. На основе видео регистрации процесса построены кинетические кривые СПК, ОПК и ДПК [1 - 3].

СПК ( $Cr_2O_3$ ,  $V_2O_3$ ,  $Sb_2S_3$ , Se и др.) рассматривается как морфологический аналог механизма роста Франка — ван-дер-Мерве (ФМ) при росте кристалла из паровой фазы [4, 5]. В этом случае в зоне наблюдения в аморфной пленке растет одиночный плоский кристалл. По аналогии с механизмом роста ФМ энергетический критерий СПК может быть записан как  $\sigma_a \ge \sigma_c + \sigma_{ac} + \varepsilon_d$ , где  $\sigma_a$  есть свободная энергия границы раздела аморфная фаза - вакуум,  $\sigma_{ac}$  - свободная энергия границы раздела аморфная фаза - кристалл,  $\sigma_c$  - свободная энергия границы раздела кристалл - вакуум и  $\varepsilon_d$  - энергия деформации растущего кристаллического слоя. Для СПК выполняется квадратичная зависимость доли кристаллической фазы x от времени t и  $\delta_0 \sim 2500$  - 4700.

ОПК (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>, Ni, Re и др.) рассматривается как морфологический аналог механизма роста Фольмера — Вебера (ФВ) при росте кристаллов из паровой фазы. По аналогии с механизмом роста ФМ энергетический критерий ОПК может быть записан как  $\sigma_a \le \sigma_c + \sigma_{ac} + \epsilon_d$ . В случае ОПК в зоне наблюдения в аморфной пленке растет множество мелких разориентированных кристаллов. Для ОПК выполняется экспоненциальная зависимость x(t) и  $\delta_0 \sim 100$  - 900.

ДПК (пленки Fe-C, HfO<sub>2</sub>) рассматривается как морфологический аналог механизма роста Странского — Крастанова (СК) при росте кристаллов из паровой фазы. Характерным признаком ДПК является образование дендритных ветвей на сторонах плоского монокристалла [6]. Для ДПК выполняется квадратичная зависимость x(t) и  $\delta_0 \sim 3900$ .

## Литература:

- [1] A.G. Bagmut, Technical Physics Letters, 2012, vol. 38, 488-491.
- [2] A.G. Bagmut, I.A. Bagmut, Functional Materials, 2018, vol. 25, 525-533.
- [3] A.G. Bagmut, Journal of Advanced Microscopy Research, 2018, vol. 13, 451-457.
- [4] E. Bauer, H. Poppa, Thin Solid Films, 1972, vol. 12, 167-175.
- [5] A.G. Bagmut, Journal of Crystal Growth, 2018, vol. 492, 92-97.
- [6] G. Laemmlein, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1945, vol. 48, 177-179 (in Russian).